【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年2月10日(2011.2.10)

【公表番号】特表2010-515278(P2010-515278A)
【公表日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2010-018
【出願番号】特願2009-544322(P2009-544322)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　27/04　　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/822　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/04　　Ｃ
Ｈ０１Ｌ　27/04　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月14日(2010.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
集積回路であって、
条件付きのみで起動される能動回路領域の第１の部分と、
集積回路が起動される場合は常に起動される能動回路領域の他の部分と、を備え、
前記第１の部分は、主に第１のタイプである減結合コンデンサを含むが、前記他の部分はそのような減結合コンデンサを含まず、
前記他の部分は、主に第２のタイプである減結合コンデンサを含むが、前記第１の部分はそのような減結合コンデンサを含まず、
前記第１のタイプのコンデンサは、前記第２のタイプのコンデンサよりも高い固有のキャパシタンスおよび領域当たりより高いリーク電流を有する集積回路。
【請求項２】
請求項１記載の集積回路において、
前記第１のタイプのコンデンサおよび前記第２のタイプのコンデンサは、ともに半導体領域を覆う導体および絶縁層を有し、
前記第１のタイプのコンデンサは、前記第２のタイプのコンデンサよりも薄い絶縁層を有する集積回路。
【請求項３】
請求項１記載の集積回路において、
前記第１のタイプのコンデンサおよび前記第２のタイプのコンデンサは、ともにＭＯＳコンデンサである集積回路。
【請求項４】
請求項１記載の集積回路において、
前記第１のタイプのコンデンサおよび前記第２のタイプのコンデンサは、ともに蓄積コンデンサである集積回路。
【請求項５】
請求項１記載の集積回路において、
前記第１のタイプのコンデンサおよび前記第２のタイプのコンデンサは、ともにｎ－ウ

ェルに対するＭＯＳコンデンサである集積回路。
【請求項６】
集積回路であって、
条件付きのみで起動される能動回路領域の第１の部分と、
集積回路が起動される場合は常に起動される能動回路領域の他の部分と、を備え、
前記第１の部分は、主に領域最適化された減結合コンデンサを含むが、前記他の部分はそのような減結合コンデンサを含まず、
前記他の部分は、リーク最適化された減結合コンデンサを主に含むが、前記第１の部分はそのような減結合コンデンサを含まない集積回路。
【請求項７】
請求項６記載の集積回路において、
前記領域最適化されたコンデンサおよび前記リーク最適化されたコンデンサは、ともに半導体領域を覆う導体および絶縁層を有し、
前記領域最適化されたコンデンサは、前記リーク最適化されたコンデンサよりも薄い絶縁層を有する集積回路。
【請求項８】
請求項６記載の集積回路において、
前記領域最適化されたコンデンサおよび前記リーク最適化されたコンデンサは、ともにＭＯＳコンデンサである集積回路。
【請求項９】
請求項６記載の集積回路において、
前記領域最適化されたコンデンサおよび前記リーク最適化されたコンデンサは、ともにｎ－ウェルに対するＭＯＳコンデンサである集積回路。
【請求項１０】
集積回路であって、
条件付きのみで起動される第１の部分と、
チップが電源遮断状態から起動される場合は常に起動される能動回路領域の他の部分と、を備え、
前記第１の部分および前記他の部分は、実質的に同一のゲート構造を有する対応する電界効果トランジスタを含み、
前記第１の部分は、主に蓄積コンデンサであり前記ゲート構造と実質的に同じ薄膜層を使用する減結合コンデンサを含むが、前記他の部分はそのような減結合コンデンサを含まず、
前記他の部分は、主に蓄積コンデンサであり前記ゲート構造と同じ薄膜層を使用しない減結合コンデンサを含むが、前記第１の部分はそのような減結合コンデンサを含まない集積回路。
【請求項１１】
集積回路であって、
ゲート電圧の第１の範囲用に最適化された第１の絶縁ゲートトランジスタを含む第１の領域と、
前記第１の範囲のいずれの部分よりも高い数電圧を含む作動電圧の第２の範囲用に最適化された第２の絶縁ゲートトランジスタを含む第２の領域と、を備え、
前記第１の領域は、条件付きのみで起動されるいくつかの部分と、前記第１の領域が起動される場合は常に起動される他の部分とを含み、
前記条件付きで起動される部分は、主に第１のタイプのものであり、前記第１のトランジスタと同じプロセスによって形成された減結合コンデンサを含み、
前記他の部分は、主に、前記第１のタイプのものではない減結合コンデンサを含む集積回路。
【請求項１２】
請求項１１記載の集積回路において、

前記条件付きで起動される部分は、主に第１のタイプのものであり、前記第１のトランジスタと同じプロセスによって形成された減結合コンデンサを含むが、前記他の部分はそのような減結合コンデンサを含まず、

前記他の部分は、主に、前記第２のトランジスタと同じプロセスによって形成された減結合コンデンサを含む集積回路。

【請求項１３】

請求項１１記載の集積回路において、

前記他の部分は、主に蓄積コンデンサであり、前記ゲート構造と同じ薄膜層を使用しない減結合コンデンサを含むが、前記条件付きで起動される部分はそのような減結合コンデンサを含まない集積回路。

【請求項１４】

請求項１１記載の集積回路において、

前記第２の領域は外部Ｉ／Ｏ回路を含み、前記第１の領域は外部Ｉ／Ｏ回路を含まない集積回路。